

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2017-195178

(P2017-195178A)

(43) 公開日 平成29年10月26日(2017. 10. 26)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
HO 1 J 37/073 (2006.01)	HO 1 J 37/073	5C030
HO 1 J 19/02 (2006.01)	HO 1 J 19/02	
HO 1 J 37/06 (2006.01)	HO 1 J 37/06 A	
HO 1 J 9/12 (2006.01)	HO 1 J 37/06 Z	
	HO 1 J 9/12 B	

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 19 頁)

(21) 出願番号 特願2017-69378 (P2017-69378)  
 (22) 出願日 平成29年3月30日(2017. 3. 30)  
 (31) 優先権主張番号 特願2016-81955 (P2016-81955)  
 (32) 優先日 平成28年4月15日(2016. 4. 15)  
 (33) 優先権主張国 日本国(JP)

申請有り

(71) 出願人 504151365  
 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構  
 茨城県つくば市大穂1番地1

(71) 出願人 504139662  
 国立大学法人名古屋大学  
 愛知県名古屋市千種区不老町1番

(74) 代理人 100093816  
 弁理士 中川 邦雄

(72) 発明者 金 秀光  
 茨城県つくば市大穂1番地1 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構内

(72) 発明者 竹田 美和  
 愛知県長久手市蟹原404番地 第3レオン光園3-A

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 スピン偏極高輝度電子発生フォトカソード及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】本発明は、簡易な構造を有する裏面照射用のスピン偏極高輝度電子発生フォトカソード及びその製造方法を提供することを目的とする。

【解決手段】ナノメートルの表面平坦性を有する単結晶基板の上にNEA性を有する単結晶化合物半導体の薄膜を形成させる。本発明スピン偏極高輝度電子発生フォトカソードは、有機金属気相成長法を用いて製造することができる。

【選択図】 図2

